

УДК 539.184

Н.К. Крамар, В.М. Крамар, Б.М. Ніцович

## Розрахунок оптичних параметрів шаруватого напівпровідникового кристала PbI<sub>2</sub>

Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича,  
вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58012, Україна

На основі розрахованого з перших принципів методом псевдопотенціалу зонного спектра визначено оптичні параметри кристалу, зокрема спектри поглинання і відбивання шаруватого напівпровідникового кристалу PbI<sub>2</sub>.

**Ключові слова:** шаруватий кристал, дийодид свинцю, оптичні параметри, спектри поглинання і відбивання.

Стаття постуила до редакції 17.11.2001; прийнята до друку 3.06.2002

Для більшості шаруватих кристалів характерна анізотропія фізичних параметрів, наприклад ефективних мас носіїв заряду [1], спектрів поглинання і відбивання [2], що пояснюється специфічною будовою їх електронного і коливного спектрів, обумовленою особливостями кристалічної структури.

В даній роботі приводяться результати обчислень ряду оптичних параметрів шаруватого напівпровідника PbI<sub>2</sub>, виконаних на основі розрахованого в [3] енергетичного спектру його електронної системи методом псевдопотенціалів з використанням нелокального "з перших принципів" псевдопотенціалу [4], що зберігає норму псевдохвильових функцій. У першому порядку теорії збурень їх можна шукати у вигляді розвинення у базисі плоских хвиль:

$$|\varphi_{n\vec{k}}\rangle = a_{n\vec{k}}(0)|\vec{k}\rangle + \sum_{\vec{g} \neq 0} a_{n\vec{k}}(\vec{g})|\vec{k} - \vec{g}\rangle$$

де  $a_{n\vec{k}}(0)$  та

$$a_{n\vec{k}}(\vec{g}) = \frac{\langle \vec{k} - \vec{g} | V_{ps} | \vec{k} \rangle}{T_{\vec{k}} - T_{\vec{k} - \vec{g}}} a_{n\vec{k}}(0), \quad (\vec{g} \neq 0)$$

– члени, відповідно, нульового та першого порядків по псевдопотенціалу  $V_{ps}$  ( $T_{\vec{k}} = \hbar^2 k^2 / 2m$  – енергія вільного електрона і  $T_{\vec{k}} \neq T_{\vec{k} - \vec{g}}$ ), які можна знайти розв'язуючи секулярне рівняння. У [3] знайдено явний вигляд форм-факторів нелокального псевдопотенціалу для атомів свинцю і йоду і проведено процедуру самоузгодженого розрахунку елементів матриці секулярної задачі з урахуванням ефектів екранування атомних потенціалів і обмінно-кореляційної взаємодії. У першому порядку теорії збурень вони визначаються як самоузгоджені по величині  $\sum_{n, \vec{k}} |a_{n\vec{k}}(0)|^2$  розв'язки рівняння

$$\langle \vec{K}' | V_{ps} | \vec{K} \rangle = \langle \vec{K}' | V_{ps}^b | \vec{K} \rangle + \left( \frac{16\pi}{g^2 \Omega} - \frac{\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{\pi \Omega} [\sum_{n, \vec{k}} |a_{n\vec{k}}(0)|^2]^{2/3}} \right) \times \sum_{n, \vec{k}} |a_{n\vec{k}}(0)|^2 \frac{\langle \vec{K}' | V_{ps} | \vec{K} \rangle}{T_{\vec{K}} - T_{\vec{K}'}}$$

з нульовим наближенням  $\langle \vec{K}' | V_{ps} | \vec{K} \rangle^{(0)} = \langle \vec{K}' | V_{ps}^b | \vec{K} \rangle$  (тут  $\vec{K} = \vec{k} - \vec{g}$ ). Величини коефіцієнтів  $a_{n\vec{k}}(0)$  знаходяться у кожній точці  $\vec{k}$  на кожному етапі ітераційної процедури пошуку розв'язків секулярного рівняння, що містить їх у якості параметрів самоузгодження, як

компоненти відповідних власних векторів одноелектронного псевдогамільтоніану у базисі плоских хвиль і дозволяють розрахувати уявну частину діелектричної функції [5]

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{e^2 \hbar^2}{3\pi m^2 \omega^2} \sum_{c, v} \int d^3 k \delta(E_c(\vec{k}) - E_v(\vec{k}) - \hbar\omega) \times |\langle \varphi_{v\vec{k}} | \vec{V} \cdot \vec{e} | \varphi_{c\vec{k}} \rangle|^2 \quad (1)$$

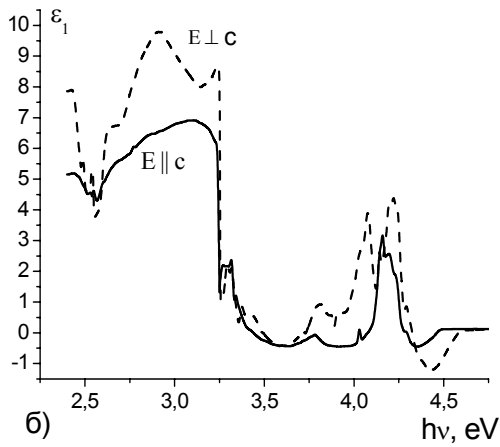
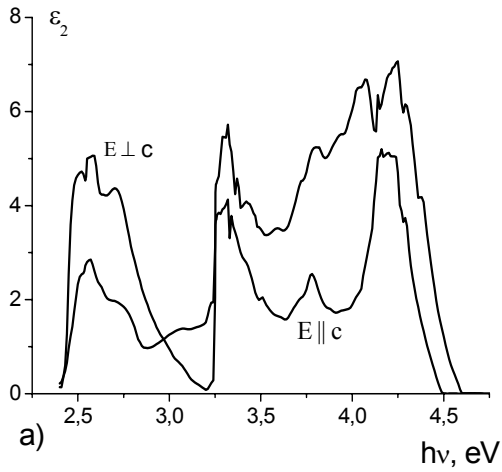


Рис. 1. Спектральні залежності уявної а) та дійсної б) частин діелектричної функції  $PbI_2$ .

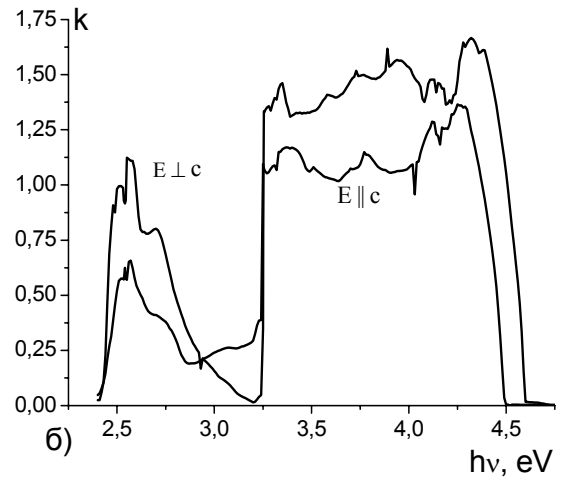
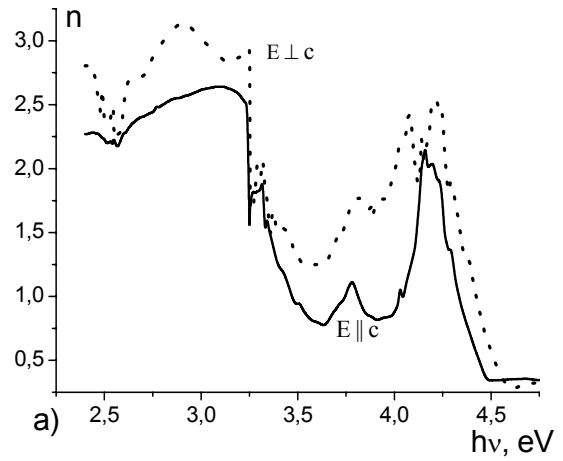


Рис. 2. Спектральні залежності показників заломлення а) і поглинання б) кристалу  $PbI_2$ .

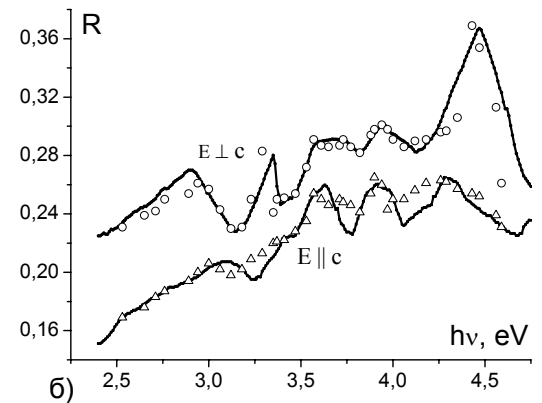
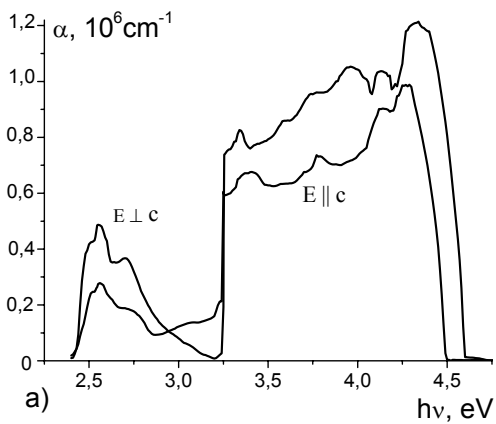


Рис. 3. Спектри поглинання а) та відбивання; б)  $PbI_2$  (○ та Δ – результати вимірювань [5]).

де через  $E_v(\vec{k})$  і  $E_c(\vec{k})$  позначено енергії валентної зони і зони провідності, а  $\vec{e}$  – вектор поляризації

падаючого світла. Інтеграл у (1) може бути записаний у вигляді [6]

$$\int \frac{dS}{|\vec{\nabla}_{\vec{k}} \omega(\vec{k})|} |\langle \varphi_{\vec{v}\vec{k}} | \vec{\nabla} \cdot \vec{e} | \varphi_{\vec{c}\vec{k}} \rangle|^2, \quad (2)$$

де інтегрування здійснюється вздовж поверхні постійної енергії  $E_c(\vec{k}) - E_v(\vec{k}) = \hbar\omega$ . Процедура інтегрування реалізована методом тетрадрів [6] з використанням набору точок незвідної частини зони Бріллюена. Реальна частина діелектричної функції знаходилась за співвідношенням Крамерса-Кроніга:

$$\varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\omega' \varepsilon_2(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (3)$$

з використанням розрахованої залежності  $\varepsilon_2(\omega)$  в межах інтервалу енергій 2,4...8,5 eV та її аналітичного продовження у вигляді запропонованої в [5] функції  $\beta\omega/(\omega^2 + \gamma^2)$ , де  $\beta$  і  $\gamma$  підібрані відповідно параметри.

Результати розрахунків для двох поляризацій: у площини шарового пакету ( $\vec{E} \perp c$ ) та

перпендикулярно до неї ( $\vec{E} \parallel c$ ), подані на рис. 1.

Знайдені залежності  $\varepsilon_1(\omega)$  і  $\varepsilon_2(\omega)$  дозволяють встановити оптичні параметри кристала (рис. 2), спектри поглинання в області міжзонних переходів, а також спектри відбивання (рис. 3), які узгоджуються з результатами експериментальних вимірювань при 4,2 К, наведеними в [5].

**Н.К. Крамар** – молодший науковий співробітник кафедри оптики і спектроскопії;

**В.М. Крамар** – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри оптики і спектроскопії;

**Б.М. Ніцович** – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики і спектроскопії.

- [1] М.С. Бродин, И.В. Блонский. *Экситонные процессы в слоистых кристаллах*. Наукова думка, К. (1986).
- [2] Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства / Под ред. А.Б. Лысковича. Вища школа, Львов, (1982).
- [3] Н.К. Крамар, В.М. Крамар, Б.М. Ніцович. Розрахунок ефективних мас електронів і дірок у шаруватому напівпровідниковому кристалі PbI<sub>2</sub> // *Фізика і хімія твердого тіла* **2**(3), сс. 423-431 (2001).
- [4] G.V. Bachelet, D.R. Hamann, M. Schlüter. Pseudopotentials that work: From H to Pu // *Phys. Rev. B.*, **26**(8) pp. 4199-4228 (1982).
- [5] M. Schlüter, I.Ch. Schlüter. Electronic structure and optical properties of PbI<sub>2</sub> // *Phys. stat. sol. (b).*, **57**(4) pp. 1652-1663 (1973).
- [6] Достижения электронной теории металлов / Под ред. П. Цише, Г. Лиманна. Мир, М., (1984).

N.K. Kramar, V.M. Kramar, B.M. Nitsovych

## Calculations of the Optical Constants of the Layer Semiconductor Crystal PbI<sub>2</sub>

*Chernivtsi National University,  
2 Kotsyubinsky Str., 58012, Chernivtsi, Ukraine*

On the base of 'ab initio' pseudopotential method the energy spectra calculations there were obtained the real and imaginary parts of dielectric function of the layer semiconductor PbI<sub>2</sub>. This allows to calculate optical constants of the crystal, in particular, here absorption and reflectivity.